

2SA839

シリコンPNP三重拡散メサ形トランジスタ
SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR (TENTATIVE)

○低周波電力増幅用 ○励振段電力増幅用

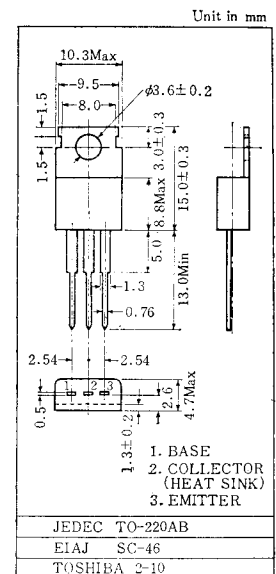
○ Audio Power Amplifier Applications

○ Driver Stage Amplifier Applications

- 高耐圧です： $V_{CEO} = -150V$
- 高出力 Hi-Fi Amp. の励振段に適します。
- 2SC1669 とコンプリメンタリになります。
- Complementary to 2SC1669

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-150	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-150	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-1.5	A
エミッタ電流	I_E	1.5	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_C	25	W
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$



アクセサリはAC75を適用
MOUNTING KIT NO. AC75

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -100V, I_E = 0$	—	—	-20	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	—	—	-10	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -10mA, I_B = 0$	-150	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -1mA, I_C = 0$	-5	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ Note	$V_{CE} = -10V, I_C = -0.5A$	40	—	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -10V, I_C = -1A$	20	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -500mA, I_B = -50mA$	—	—	-1.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -10V, I_C = -0.5A$	-0.7	—	-1.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -10V, I_E = 0.5A$	—	6	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	100	—	pF

Note ; $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of $h_{FE(1)}$, the 2SA839 is classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SA839—R	40	80
2SA839—O	70	140
2SA839—Y	120	240